

DOCKET NO.: 273258US2PCT

01537416 JC17 Rec'd PCT/PTO 0 2 JUN 2005

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Haruhiko HIEDA, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP04/03297

INTERNATIONAL FILING DATE: March 12, 2004

FOR: CONNECTION STRUCTURE FOR COAXIAL CONNECTOR AND MULTILAYER

SUBSTRATE

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY

APPLICATION NO

DAY/MONTH/YEAR

Japan

2003-068205

13 March 2003

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP04/03297.

> Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,

MAIER & NEUSTADT, P.C.

Customer Number

22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03)

Marvin J. Spivak Attorney of Record Registration No. 24,913 Surinder Sachar

Registration No. 34,423

Corwin P. Umbach, Ph.D. Registration No. 40,211

JP2004/003297

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

12. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月13日

REC'D 2 9 APR 2004

WIPO

PCT

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-068205

[ST. 10/C]:

[JP2003-068205]

出 願 Applicant(s):

三菱電機株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月14日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

544014JP01

【提出日】

平成15年 3月13日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01P 5/08

H01R 13/646

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

稗田 晴彦

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

浅尾 英喜

【特許出願人】

【識別番号】

000006013

【氏名又は名称】

三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】

100066474

【弁理士】

【氏名又は名称】

田澤 博昭

【選任した代理人】

【識別番号】

100088605

【弁理士】

【氏名又は名称】

加藤 公延

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

020640

【納付金額】

21,000円

ページ: 2/E

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板-同軸コネクタの接合構造

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性の筐体内に実装した高周波基板と同軸コネクタとを電気的に接続する基板-同軸コネクタの接合構造において、

前記高周波基板と前記同軸コネクタとの間に、その両者を電気的に接続する仲 介用基板を配置したことを特徴とする基板ー同軸コネクタの接合構造。

【請求項2】 高周波基板と仲介用基板とがコプレーナ型伝送線路で電気的に接続されていることを特徴とする請求項1記載の基板-同軸コネクタの接合構造。

【請求項3】 同軸コネクタと仲介用基板とがコプレーナ型伝送線路で電気的に接続されていることを特徴とする請求項1または請求項2記載の基板-同軸コネクタの接合構造。

【請求項4】 仲介用基板は両面基板からなっていることを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載の基板-同軸コネクタの接合構造。

【請求項5】 高周波基板は多層基板からなっていることを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載の基板-同軸コネクタの接合構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えば通信装置の高周波回路等に用いる基板ー同軸コネクタの接合構造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来の基板-同軸コネクタの接合構造においては、導電性の筐体内に実装された高周波多層基板(以下、多層基板という)の伝送線路信号線パターン(以下、 導電性パターンという)と同軸コネクタの芯線とを適当な蝋材によって直接電気 的に接続している(例えば、特許文献1参照)。

[0003]

【特許文献1】

特開2001-177311公報

[0004]

次に動作について説明する。

同軸コネクタから入力された高周波信号は、同軸コネクタと多層基板との接合部を通過し、多層基板上に形成された伝送線路上を伝播して行き、その逆方向の伝播路においても、前記伝送線路上を伝播してきた高周波信号は、同軸コネクタと多層基板との接合部を通過して同軸コネクタへと伝播して行く。

[0005]

以上において、同軸コネクタと多層基板との接合部では、多層基板の厚みによって、筐体上の接地面と同軸コネクタの芯線との間隔が広がり、この領域においては、伝送線路としてのインピーダンスが大幅に乱れ、誘電性を引き起こす結果となる。ここで、多層基板の肉厚が厚くなるほど前記誘電性の度合いが大きくなる傾向にある。さらに、多層基板では、該基板最上層の伝送線路パターンとその直下層の接地パターンを基板端面まで形成することが難しいため、その基板端面と前記接地パターンの端部との間には大きなパターンマージンが生じる。そのため、多層基板の端面近傍では、伝送線路を構成する接地パターンを形成することができず、従って、その領域においても、伝送線路のインピーダンスが大幅に乱れ、誘電性を引き起こすという問題がある。

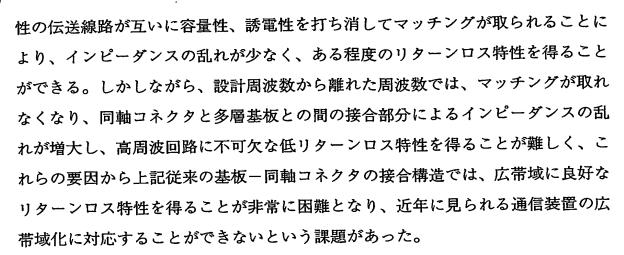
[0006]

そこで、上記従来の基板ー同軸コネクタの接合構造では、同軸コネクタに容量性の同軸線路を設けることによって、上述のような伝送線路の誘電性を打ち消す構成とし、これにより、インピーダンス整合を図り、その特性を確保するようにしている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

従来の基板-同軸コネクタの接合構造は以上のように構成されているので、インピーダンス整合が成されるように設計された周波数近傍では、同軸コネクタに 設けられた容量性の同軸線路と同軸コネクタと多層基板間の接合部分による誘電



[0008]

この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、同軸コネクタと基板との電気的接合部分によるインピーダンスの乱れを大幅に軽減することができて優れたリターンロス特性を広帯域で確保することができる基板一同軸コネクタの接合構造を得ることを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

この発明に係る基板ー同軸コネクタの接合構造は、導電性の筐体内に実装した 高周波基板と同軸コネクタとの間に、その両者を電気的に接続する仲介用基板を 配置したものである。

[0010]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の一形態を説明する。

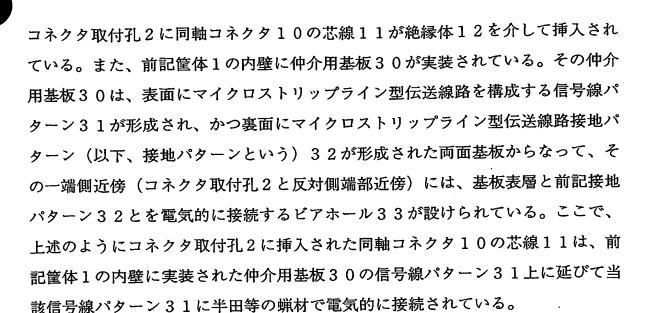
実施の形態 1.

図1はこの発明の実施の形態1による基板-同軸コネクタの接合構造を示す縦 断側面図、図2は図1の一部切欠平面図である。

図1および図2に示すように、導電性の筐体1には同軸コネクタ10と多層基板(高周波基板)20とが実装され、その同軸コネクタ10と多層基板20との間には両者を電気的に接続する仲介用基板30が配置されている。

[0011]

さらに詳述すると、前記筐体1の側壁にはコネクタ取付孔2が設けられ、この



[0012]

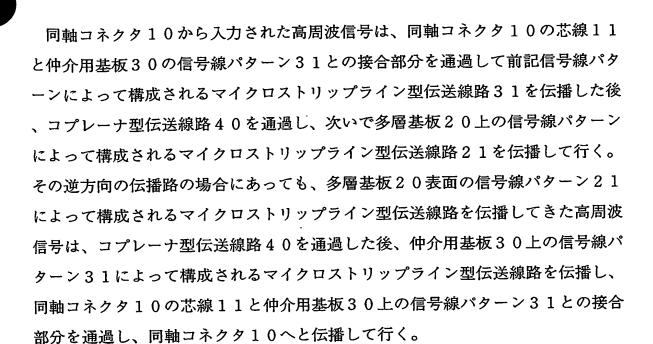
また、前記筐体1の内壁には、そのコネクタ取付孔2との反対側に前記仲介基板30と隣り合うように多層基板20が実装されている。その多層基板20は、表面のマイクロストリップライン型伝送線路を構成する信号線パターン21と、基板内層のマイクロストリップライン伝送線路接地パターン(以下、基板内層接地パターンという)22と、基板裏面接地パターン23とを有すると共に、それらのパターン22、23と基板表層の相互を前記仲介用基板30寄りで電気的に接続するビアホール24を有している。

[0013]

そして、前記多層基板20と仲介用基板30との隣接側表面において、その両者の信号線パターン21,31の相互がリボンボンディング等で電気的に接続されている。同様にして、前記ビアホール24,33の相互がリボンボンディング等によって電気的に接続されている。このようにして、仲介用基板30の信号線パターン31と多層基板20の表面の信号線パターン21、そして各接地パターン22,23,32とがコプレーナ型伝送線路40,40aで電気的に接続された伝送線路が形成される。すなわち、その伝送線路は、仲介用基板30と多層基板20とに跨って連続した高周波伝送線路を構成しているものである。

[0014]

次に動作について説明する。



[0015]

以上説明した実施の形態1によれば、導電性の筐体1に実装された多層基板20と同軸コネクタ10との間に仲介用基板30を配置し、当該仲介用基板30上の信号線パターン31と前記同軸コネクタ10の芯線11とを電気的に接続すると共に、前記仲介用基板30上の信号線パターン31と多層基板20の表面信号線パターン21とをコプレーナ型伝送線路40で電気的に接続するように構成したので、インピーダンスの乱れが大幅に軽減できて優れたリターンロス特性を広帯域に確保することができるという効果がある。

[0016]

すなわち、上記実施の形態1によれば、同軸コネクタ10と仲介用基板30との電気的接合部分ではインピーダンスの乱れが生じるが、多層基板20の回路とは異なり、仲介用基板30上には制御系回路を搭載する必要がなく、このため、前記仲介用基板30を最適な基板形状および設計とすることができる。そのため、仲介用基板30においては、その厚みを極力薄くすることができ、これにより、多層基板20を同軸コネクタ10に対して電気的に直接接続する構造に比べて、仲介用基板30の表面の信号線パターン31と裏面の接地パターン32および筐体上の接地面と同軸コネクタの芯線11とを大幅に近づけることができ、この領域においては、伝送線路としてのインピーダンスの乱れを大きく改善できると



いう効果がある。

[0017]

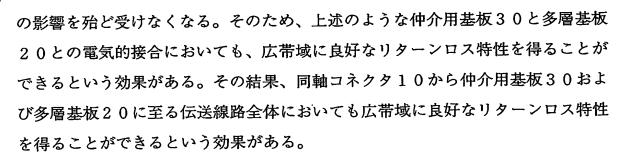
さらに、前記多層基板20では、最上層の信号線パターン21とその直下の内層接地パターン22とによって形成されているマイクロストリップライン型伝送線路の前記内層接地パターン22を基板端面まで形成することが難しいために、その内層接地パターン22の端面と基板端面との間にはパターンマージンM1(図1および図2参照)が生じるが、前記仲介用基板30は多層基板ではなく単層の両面基板からなっているので、前記仲介用基板30として例えばアルミナ基板を用いることにより、その基板裏面の接地パターン32の端面と基板端面との間のパターンマージンM2を大幅に狭めることができる。すなわち、前記仲介用基板30にあっては、その裏面の接地パターン32を基板端面近くまで形成することができ、このため、多層基板20で生じていた基板端面付近での伝送線路のインピーダンスの乱れを大幅に軽減することが可能になるという効果がある。その結果、上述のような同軸コネクタ10と仲介用基板30との接合によって、広帯域に優れたリターンロス特性を得ることができるという効果がある。

[0018]

ここで、多層基板 2 0 と仲介用基板 3 0 の表面に共通のマイクロストリップライン型伝送線路を形成する信号線パターン 2 1,3 1 同士を接続し、その両基板 2 0,3 0 間を接続するような構造にすると、多層基板 2 0 の内層パターンマージンM 1 や多層基板 2 0 の厚みおよび基板ギャップ壁の厚みが大きいため、両基板 2 0,3 0 間の接合部分で大幅にインピーダンスが乱れ、良好なリターンロス特性を得ることができない。

[0019]

しかし、上記実施の形態1では、仲介用基板30上の信号線パターン31と多層基板20上の信号線パターン21とをリボンボンディング等によるコプレーナ型伝送線路40で接合したことにより、その接合部分での電磁界は、コプレーナ型伝送線路40のみに集中して伝播し、基板内部への電磁界分布は激減するため、前記多層基板20の内層接地パターン22の有無による当該基板端面近くの伝送線路や基板ギャップ壁および多層基板20の厚みによるインピーダンスの乱れ



[0020]

実施の形態2.

図3はこの発明の実施の形態2による基板-同軸コネクタの接合構造を一部切欠して示す平面図であり、図1および図2と同一または相当部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

この実施の形態2では、上記実施の形態1による基板-同軸コネクタの接合構造において、仲介用基板30の同軸コネクタ10側の端部付近にも2つの同軸コネクター仲介用基板間ビアホール34を設け、当該ビアホール34と導電性筐体1とをリボンボンディング等による2本の仲介用基板接続線路41で電気的に接続する構成としたものである。

[0021]

このような構成の実施の形態2によれば、2つの同軸コネクター仲介用基板間ビアホール34から導電性筐体1に対し電気的に接続されている2本の同軸コネクター仲介用基板接続線路41と同軸コネクタ10の芯線11とによって、コプレーナ型伝送線路が形成されるので、同軸コネクタ10の芯線11のみで同軸コネクタ10と仲介用基板30とを電気的に接続した場合よりもインピーダンスの乱れをいっそう効果的に抑止することができ、従って、上記実施の形態1の場合よりも、さらにリターンロスを改善することができるという効果がある。

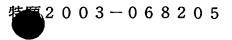
[0022]

実施の形態3.

図4はこの発明の実施の形態3による基板-同軸コネクタの接合構造を一部切欠して示す平面図であり、図3との同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

この実施の形態3では、上記実施の形態2による基板-同軸コネクタの接合構





造において、仲介用基板30の表面にマイクロストリップラインではなくコプレーナ型伝送線路35を形成したものである。

[0023]

このように上記実施の形態3では、仲介用基板30の表面にコプレーナ型伝送 線路35を形成するように構成したので、同軸コネクター仲介用基板間ビアホー ル34から導電性筐体1に接続されている2本の同軸コネクター仲介用基板接続 線路41と同軸コネクタ10の芯線11とによりコプレーナ型伝送線路が形成さ れ、このコプレーナ型伝送線路から仲介用基板30に電磁波が伝播される場合、 また、その逆方向に電磁波が伝播される場合のいずれにおいても、常にコプレー ナ型の電磁界伝送モードを保ったまま伝播することができ、そのため、マイクロ ストリップライン型とコプレーナ型の電磁界伝送モード変換の必要がある、仲介 用基板30表面にマイクロストリップライン型伝送線路が形成されている場合よ りもリターンロスの劣化を抑止できるという効果がある。同様にして、仲介用基 板30からコプレーナ型伝送線路40に電磁波を伝播する場合、または、その逆 方向に電磁波を伝播する場合にも、常にコプレーナ型の電磁界伝送モードを保っ たまま伝播することができるため、マイクロストリップライン型とコプレーナ型 の電磁界伝送モード変換の必要がある、仲介用基板30の表面にマイクロストリ ップライン型伝送線路のみを形成した場合よりもリターンロスの劣化を抑止でき るという効果がある。従って、この実施の形態3では上記実施の形態2よりも、 さらにリターンロスを改善できるという効果がある。

[0024]

実施の形態4.

図5はこのこの発明の実施の形態4による基板-同軸コネクタの接合構造を一部切欠して示す平面図であり、図3との同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

上記実施の形態3では、上記実施の形態2における仲介用基板30上のマイクロストリップライン型伝送線路31をコプレーナ型伝送線路35に代えたが、この実施の形態4では、上記実施の形態2における多層基板20上のマイクロストリップライン型伝送線路21をコプレーナ型伝送線路25に代えたものである。



この実施の形態4によれば、多層基板20の表面に上記実施の形態2のマイクロストリップライン型伝送線路21に代わるコプレーナ型伝送線路25を形成するように構成したので、多層基板20からコプレーナ型伝送線路25に電磁波が伝播する場合、または、その逆方向に電磁波が伝播する場合のいずれにおいても、常にコプレーナ型の電磁波伝送モードを保ったまま伝播することができ、そのため、マイクロストリップライン型とコプレーナ型の電磁界伝送モード変換の必要がある、多層基板20の表面にマイクロストリップライン型伝送線路を形成した場合よりもリターンロスの劣化を抑止できるという効果がある。従って、この実施の形態4では上記実施の形態2よりも、さらにリターンロスを改善できるという効果がある。

[0026]

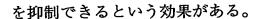
実施の形態5.

図6はこのこの発明の実施の形態5による基板-同軸コネクタの接合構造を一部切欠して示す平面図であり、図3との同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

この実施の形態5では、仲介用基板30と多層基板20の両方の表面に、上記 実施の形態2におけるマイクロストリップライン型伝送線路31と21に代わる コプレーナ型伝送線路35と25を形成したものである。

[0027]

このように仲介用基板30と多層基板20の両方の表面にコプレーナ型伝送線路35と25を形成した実施の形態5によれば、同軸コネクター仲介用基板間ビアホール34から導電性筐体1に接続されている2本の導電性筐体ー仲介用基板接続線路41と同軸コネクタ10の芯線11とによって形成されたコプレーナ型伝送線路から仲介用基板30に電磁波が伝播される場合、または、その逆方向に電磁波が伝播される場合のいずれにおいても、常にコプレーナ型の電磁界伝送モードを保ったまま伝播することができ、そのため、マイクロストリップライン型とコプレーナ型の電磁界伝送モード変換の必要がある、仲介用基板30の表面にマイクロストリップライン型伝送線路を形成した場合よりもリターンロスの劣化



[0028]

また、仲介用基板30からコプレーナ型伝送線路40に電磁波が伝播する場合、また、その逆方向に電磁波が伝播する場合のいずれにおいても、常にコプレーナ型の電磁界伝送モードを保ったまま伝播することができるため、マイクロストリップライン型伝送線路が形成されている場合よりもリターンロスの劣化を抑止できるという効果がある。さらには、多層基板20からコプレーナ型伝送線路40に電磁波が伝播する場合や、その逆方向に電磁波を伝播する場合のいずれにおいても、常にコプレーナ型の電磁界伝送モードを保ったまま伝播することができるため、マイクロストリップライン型とコプレーナ型の電磁界伝送モード変換の必要がある、多層基板20の表面にマイクロストリップライン型伝送線路を形成した場合よりもリターンロスの劣化を抑止できるという効果がある。従って、この実施の形態5では、上記実施の形態2よりも、さらにリターンロスを改善できるという効果がある。

[0029]

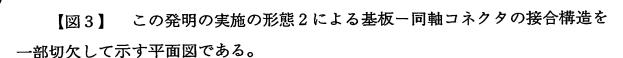
【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、導電性の筐体内に実装した高周波基板と同軸コネクタとの間に、その両者を電気的に接続する仲介用基板を配置するように構成したので、前記仲介用基板上には制御系回路を搭載する必要がなく、このため、その仲介用基板として単層の両面基板を適用することが可能となって当該仲介用基板の厚みを極力薄くすることができ、多層基板と同軸コネクタとを電気的に直接接続した従来の接合構造に比べて、前記仲介用基板の信号線パターンと同軸コネクタの芯線を接地面に対し大幅に接近させることができ、伝送線路としてのインピーダンスの乱れを大きく改善できて広帯域に優れたリターンロス特性を確保できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1による基板-同軸コネクタの接合構造を示す縦断側面図である。

【図2】 図1の一部切欠平面図である。



【図4】 この発明の実施の形態3による基板ー同軸コネクタの接合構造を 一部切欠して示す平面図である。

【図5】 この発明の実施の形態4による基板ー同軸コネクタの接合構造を 一部切欠して示す平面図である。

【図6】 この発明の実施の形態5による基板-同軸コネクタの接合構造を 一部切欠して示す平面図である。

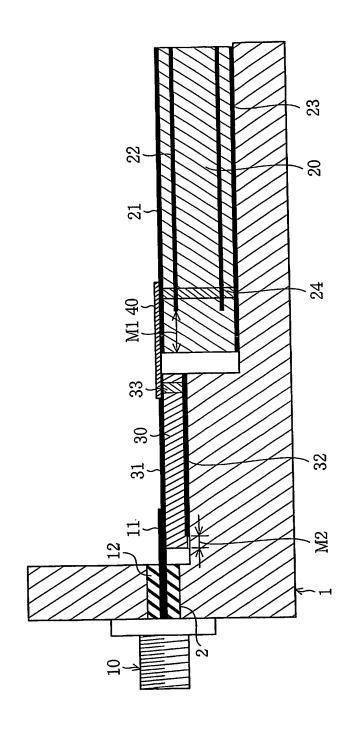
【符号の説明】

1 筐体、2 コネクタ取付孔、10 同軸コネクタ、11 芯線、12 絶縁体、20 多層基板(高周波基板)、21 信号線パターン(マイクロストリップライン型伝送線路)、22,23 接地パターン(マイクロストリップライン型伝送線路)、24 ビアホール、25 コプレーナ型伝送線路、30 仲介用基板、31 信号線パターン(マイクロストリップライン型伝送線路)、32 接地パターン(マイクロストリップライン型伝送線路)、32 ビアホール、34 同軸コネクター仲介用基板間ビアホール、35 コプレーナ型伝送線路、40,40a コプレーナ型伝送線路、41 導電性筐体ー仲介用基板接続線路、M1,M2 パターンマージン。

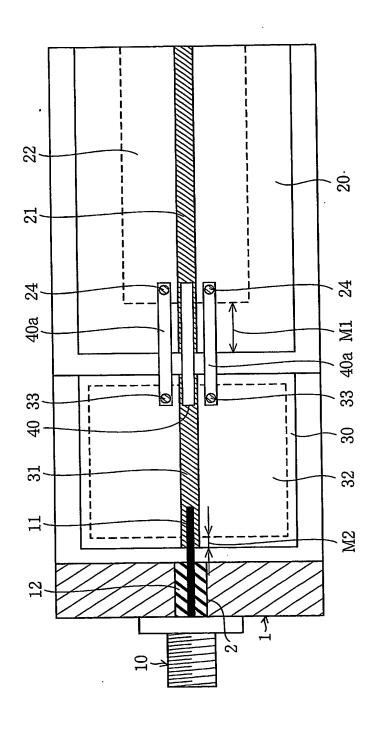


図面

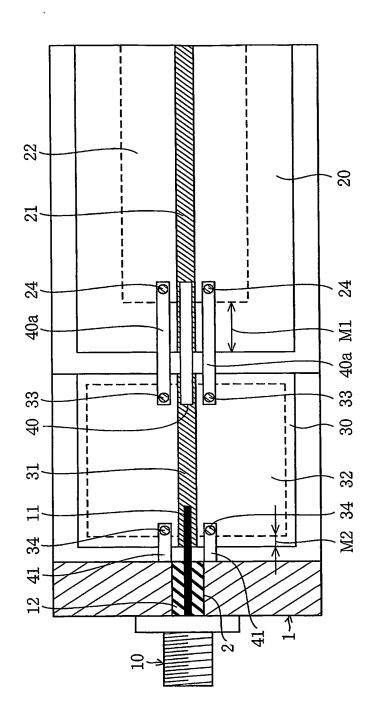
【図1】



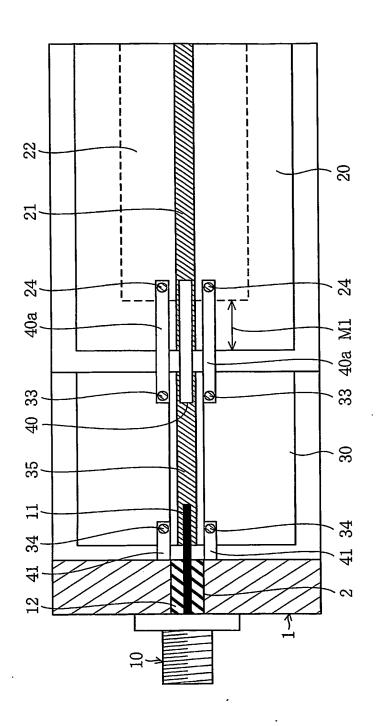




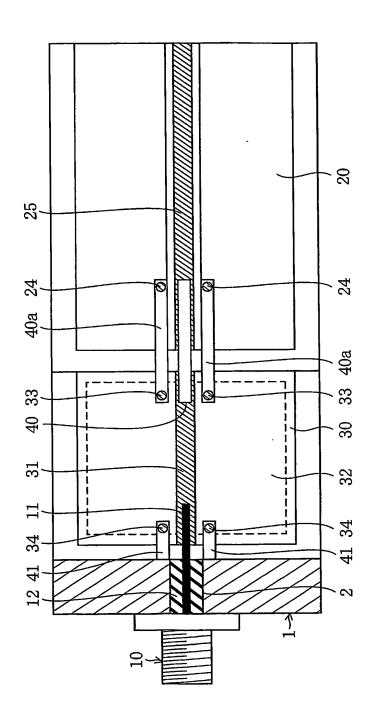






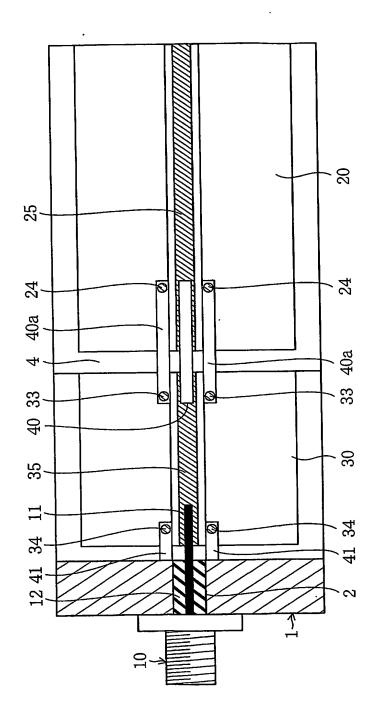








【図6】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 同軸コネクタと基板との電気的接合部分によるインピーダンスの乱れを大幅に軽減することができ、伝送線路としてのインピーダンスの乱れを大きく改善できて広帯域に優れたリターンロス特性を確保できる基板ー同軸コネクタの接合構造を得ることにある。

【解決手段】 導電性の筐体1に実装した高周波基板20と同軸コネクタ10と を電気的に接続する基板-同軸コネクタの接合構造において、前記高周波基板20と前記同軸コネクタ10との間に仲介用基板30を配置し、この仲介用基板30によって前記高周波基板20と同軸コネクタ10とを電気的に接続したものである。

【選択図】

図 1



特願2003-068205

出願人履歴情報

識別番号

. [000006013]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住所

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名

三菱電機株式会社